فوتوالكتريك

پارسا رنگريز

آزمایشگاه فیزیک ۴، دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف

۱ مقدمه

بر اثر تابش نور به مواد، الكترونها مى توانند از سطح آنها خارج شوند. این اثر را فتوالكتریک می نامند. مشاهده شده است که تعداد الکترونهای خارج شده از سطوح، به شدت نور و جنس فلز بستگی دارد؛ اما انرژی الکترونها به فرکانس نور تابیده شده وابسته است. این پدیده با در نظر گرفتن کوانتای فوتون قابل تفسیر است. بر اثر برخورد فوتونها با جسم، انرژی آنها به الکترون منتقل شده و اگر تابع کار الکترونها کمتر از انرژی فوتونها باشد، الکترونها می توانند از جسم خارج شوند. انرژی جنیشی الکترون آزاد شده را می توان از رابطه آینشتاین بدست آورد

$$T = \frac{1}{2}mv^2 = h\nu - \Phi \tag{1}$$

که m جرم الکترون، Φ تابع کار است که به جنس سطح ماده بستگی دارد، v سرعت الکترون و v فرکانس نور تابیده شده است. شکل ۱ اجزای اصلی یک لامپ فوتوسل را نشان می دهد. نور به قسمتی از لامپ که به پتانسیم و یا دیگر مواد با تابع کار کم آغشته شده است، تابیده می شود و تولید الکترونهای آزاد (فتوالکترونها) می کند. سپس در صورت اعمال میدان الکتریکی می توان الکترونها را از جسم خارج و سرعت داد. الکترونها به آندی از جنس پلاتین رسیده و تولید جریان I_P می کنند. با تغییر پتانسیل V می توان جریان V و این صورت

$$h\nu - \Phi = eV_0 \tag{7}$$

در صورتی که فرکانس نور تابیده به اندازه $\Delta \nu$ افزایش پیدا کند، مقدار انرژی الکترونها به اندازه $\hbar \Delta \nu$ افزایش پیدا کرده است. بنابراین پتانسیل منفی آند بایستی به اندازه ΔV_0 افزایش پیدا کند تا مجددا I_P برابر صفر گردد. بنابراین $\Delta V_0 = e \Delta V_0 = e \Delta V_0$ و از این رو منحنی $V_0(\nu)$ نسبت به فرکانس دارای شیب $\frac{h}{e}$ است. بدین وسیله ثابت پلانک با اندازهگیری شیب منحنی قابل اندازهگیری است.

۲ وسایل آزمایش

مجموعه اپتیکی مورد نیاز شامل قطعات زیر است و در شکل ۳ نمایش داده شده است. این مجموعه در جعبهای فلزی سیاه قرار دارد تا از بازتابهای درونی جلوگیری شود.

١) لامپ جيوه فشار بالا

٢) پوشاننده شكاف ورودي نور لامپ جيوه

۳) عدسی برای جمع کردن نور

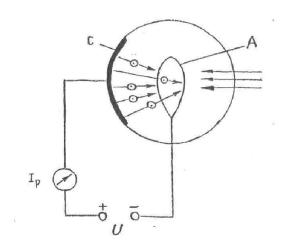
۴) شکاف

۵) عدسی برای ایجاد تصویر

۶) منشور ۱۵۰ آ د

٧) آينه

۸) ورودیهای مختلف برای اندازهگیری و اتصال فیش.



شكل ١: شماتيك سلول فوتوالكتريك



شكل ٢: سلول فوتوالكتريك

۱.۸) ورودی متصل به آمپلیفایر

۲.۸) جفت سوکت ورودی متصل به آند

۹) پیچ تغییر بازوی دستگاه برای تغییر مکان لامپ فتوسل و عدسی و شکاف موجود بر روی بازو نسبت به طول موج نور ۱۰) عَدسي پوشاننده با شكاف فلزى كه روى آن متصل مىشود. ۱۱) لامپ فتوسل (شكل ۱ و ۲). اين لامپ حاوى حلقه آند و کاتد (c) که لایهای با تابع کار کم است.

۱۲) شكاف و پوشاننده پشت لامپ

۱۳) آمپرسنج (شکل ۴) ۱۴) تقویتکننده (شکل ۵)

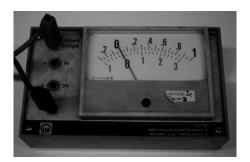
١٥) ولتمتر

شرح آزمایش

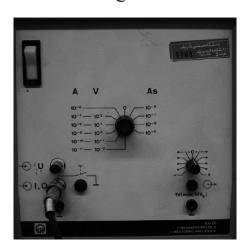
در هنگام آزمایش باید از دست زدن به قطعات تنظیمشده داخل جعبه خودداری کرد و سعی کنیم درپوش برداشته نشود. مدار آزمایش را مطابق شکل ۶ میبندیم. پتانسیل ورودی V را با استفاده از ولت متر ۲ ولت قرار میدهیم. سپس لامپ جیوه را روشن مینماییم. منبع ولتاژ را در حالت کمینه روشن نموده و بر روی γ ولت میگذاریم. دستگاه تقویتکننده I_P را در حالت کمینه روشن کرده و روی محدوده مناسب (مثلا 11-10) میگذاریم. با چرخش پتانسیومٰتر offset در حال عدم دریافت سیگنال، آن را صفر میکنیم. باید توجه داشت که تنظیم صفر آمپرسنج بسیار اهمیت دارد. با بستن دریچه از ورود هر نوری به سلول جلوگیری



شكل ٣: مجموعه اپتيكي آزمايش فوتوالكتريك

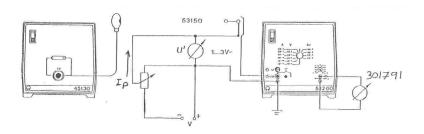


شكل ۴: آمپرسنج مورد استفاده



شكل ٥: تقويتكننده

کرده و در همین حال جریان خروجی از تقویت کننده را با کلید تنظیم روی صفر میگذاریم. درپوش ورودی نور لامپ را برداشته و به کمک پیچ تنظیم بازوی متحرک با بلند کردن در پوش جعبه به اندازه کوچک طیف را روی شکاف تنظیم مینماییم. با استفاده از رئوستا، V را تغییر داده و برای یک رنگ تابشی جریان I_P را بر حسب ولتاژ V اندازهگیری کرده و در جدول ۱ ثبت میکنیم. برای بقیه نورهای طیف، جریان I_P را به صفر رسانده و ولتاژ قطع V را در جدول ۲ مینویسیم.



شكل ۶: اجزاى آزمايش و نحوه اتصال آنان

۴ هدف آزمایش

هدف آزمایش مشخص کردن نوع آلایندگی (n یا p) یک نیمهرسانا و همچنین برای بدست آوردن σ ضریب هدایت الکتریکی و قابلیت تحرک الکتریکی بارهای یک نیمهرسانا یا رسانا، محاسبه R_H ضریب هال کریستال نیمهرسانا و همچنین اندازهگیری میدان مغناطیسی B و مطالعه خاصیت حاصل ضربی اثر هال است.

۵ جدول دادهها

با توجه به عقربه آمپرمتر، خطای آن اینگونه است:

$$\Delta I = 10\mu A \tag{7}$$

خطای فرکانس که زیر هر کدام نوشته شده است، از شکل ۹ بهره برده شده است.

$$\Delta f = \frac{\Delta \lambda}{\lambda} f \tag{f}$$

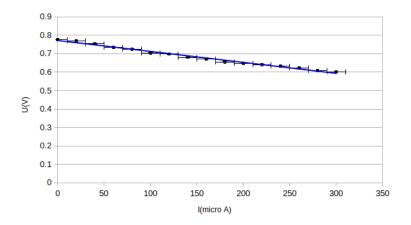
جدول ۱: جریان فوتوالکتریک بر حسب ولتاژ برای دو طیف

J	. , ,	J	
	Color:	Green	Red
	$I(\mu A)$	U(V)	$\mid U(V) \mid$
	0	0.776	0.807
	20	0.770	0.756
	40	0.754	0.679
	60	0.734	0.639
	80	0.725	0.597
	100	0.704	0.570
	120	0.698	0.538
	140	0.680	0.506
	160	0.671	0.474
	180	0.655	0.454
	200	0.648	0.431
	220	0.641	0.409
	240	0.632	0.394
	260	0.623	0.374
	280	0.609	0.358
	300	0.601	0.344

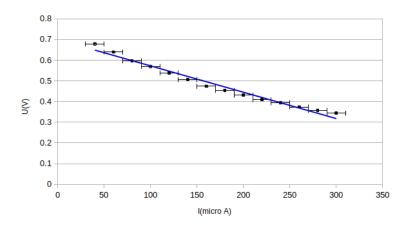
جدول ۲: ولتاژ قطع جریان برای طیفهای مختلف

f(Hz)	5.2×10^{14}	5.5×10^{14}	6.1×10^{14}	6.9×10^{14}	7.4×10^{14}
$\Delta f(Hz)$	0.2×10^{14}	0.3×10^{14}	0.1×10^{14}	0.3×10^{14}	0.3×10^{14}
Color	Yellow	Green	Green-Blue	Blue	Purple
$U_0^{(1)}(V)$	0.847	0.879	0.917	1.010	1.030
$U_0^{(2)}(V)$	0.843	0.884	0.920	1.005	1.028
$U_0^{(3)}(V)$	0.851	0.884	0.924	1.005	1.029
$ar{U_0}(V)$	0.847	0.882	0.920	1.007	1.029

۶ نمودار دادهها



شکل ۷: نمودار جدول ۱ (رنگ سبز)



شکل ۸: نمودار جدول ۱ (رنگ قرمز)

عوامل خطا که اتفاقا نتایج غیر قابل انتظار و دور از عدد دقیق را نشان میدهد به شرح زیر است:

۱) تنظیم نکردن دقیق رنگ بر روی فرکانس مورد نظر آزمایش (شکل ۹)

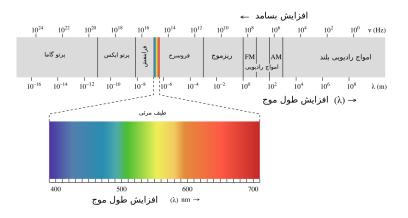
۲) بازه بسیار گسترده طیفهای متمایل به بنفش و آبی ۳) خطای سیستماتیک آمپرسنج و ولتمتر به دلیل کمبودن جریان

۴) ورود نور محیط درون محفظه تاریک آزمایش و ایجاد اخلال در سنجش جریان خطای شیب نمودار خطی فیت شده نیز اینگونه بدست می آید:

$$\Delta b = b\sqrt{\frac{1}{N-2}\left(\frac{1}{r^2} - 1\right)} \tag{(2)}$$

که N تعداد دادهها و r رگرسیون است. خطای ثابت پلانک نیز به راحتی بدست می آید:

$$\Delta h = e\Delta b \tag{9}$$



شكل ٩: بازه طيف نور مرئى

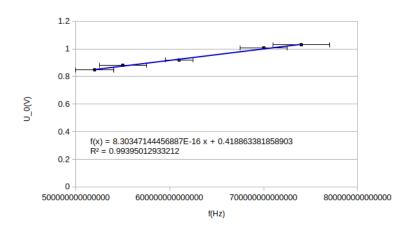
۸ نتیجه گیری

۱) نتیجه فیزیکی مهمی که میتوان از این پدیده گرفت این است که بر خلاف فیزیک کلاسیک که میزان جریان الکترونها را وابسته به شدت فوتون تابشي ميدانست، اين آزمايش در نمودارهاي جدول يک نشآن ميدهد که جريان عبوري به فرکانس تابشيي حساس است و شیب آن تغییر میکند. بنابراین به یک مفهوم جدیدی میرسیم که توجیهکننده این تناقض ظاهری است و آن بستههای انرژی فوتونهاست. ۲) از مقادیر میانگین پتانسیل قطع در جدول ۳ میتوان بهره برد و نمودار پتانسیل قطع بر حسب فرکانس را رسم کرد که مطابق شکل ۹ است. از طریق این منحنی میتوان ثابت پلانک و تابع کار فلز را یافت. در حقیقت داریم

$$U_0 = \frac{h}{e}F - \frac{\varPhi}{e}$$

با استفاده از نمودار داریم:

(V)



شكل ١٠: نمودار جدول ٢

۲) اگر از نمودار جدول دو (شکل ۱۰) بهره ببریم، میبینم که با استفاده از شیب و عرض از مبدا بدست آمده با یک آزمایش بسیار پرخطایی سر و کار داریم. به طوری که ثابت پلانک بدست آمده به صورت زیر است:

$$eb = h = (1.33 \pm 0.06) \times 10^{-34} J.t$$
 (A)

که مقدار دقیق این ثابت برابر با $10^{-34} \times 6.61$ است. بدین ترتیب ما 70 درصد خطا داریم! که به معنای واقعی فاجعه است. از طرفی عرض از مبدائی منفی داشتیم که بنابراین نمیتوان کار کار فلز را محاسبه کرد؛ اما ذکر این نکته مهم است که چون خطای فرکانس بالاست، میتوان این امید را داشت که عرض از مبدا منفی نیز شود ولی در محاسبات ما این اتفاق رخ نداد.

۳) تابع کار فلز، انرژی نیاز برای الکترون است که اگر چنین انرژی دریافت کند میتواند از نیروهای درون فلزی که الکترون را مقید میکند، فرار کرده و از فلز گسیل شود. مقدار این تابع، به جنس فلز مورد آزمایش بستگی دارد.

 ۴) الف) فیزیک کلاسیک قادر به توصیف نمودارهای جدول ۱ نیست چرا که اگر شدت تابشی یکسان باشد و فرکانس متفاوت، نباید جریان عبوری وابسته به فرکانس شود و فیزیک کلاسیک قادر به توصیف این پدیده نیست. ضمنا ولتاژ قطع فلز با اینکه تابشی صورت می پذیرد، رخ می دهد ولی در فیزیک کلاسیک، با داشتن یک تابش، حتما باید جریان عبوری رخ دهد.

 ϕ) فیزیک جدید با معرفی پدیده ای به نام کوانتای انرژی، سعی بر رفع این مشکل میکند. به طوری که نور از قوتون تشکیل شده و هر فوتون بسته ای از انرژی به همراه خود دارد و انرژی هر فوتون وابسته به فرکانس نور تابیده شده است. (E=hf) در این صورت هر فوتونی که انرژی خود را به الکترون بدهد، آن الکترون می تواند از فلز عبور کند یا نکند و تمام این پدیده وابسته به فرکانس تابیده شده است. یعنی شدت چه بالا رود چه نرود، اگر فرکانس کم باشد، فوتونی که به الکترون می رسید بسته انرژی کمی به الکترون می دهد تا فرار کند و جریانی بوجود نمی آید. اما اگر به فرکانس مورد نظر رسیدیم، با افزایش شدت، جریان نیز افزایش می یابد چون احتمال رسیدن فوتون ها به الکترون ها بیشتر می شود. ضمنا با تابش به فلز، جریان شروع می شود در صورتی که در کلاسیک چنین اتفاقی محال است. ولی دریافت فوتون توسط الکترونها آنی رخ می دهد.

۵) در ساخت سلولهای فوتوالکتریک معمولا از فلزات قلیایی نظیر پتاسیم استفاده میشود؛ چرا که در لایه ظرفیت خود تنها یک الکترون دارند و بنابراین انرژی کمتری برای فرار از اتم نیاز دارند و به این سبب تابع کار فلز کمتر خواهد بود.

۶) سلولهای فوتوالکتریک در بازپردازش صدای سینماً، تنظیم دمای کوره، تنظیم روشن و خاموش شدن چراغهای برقی، مطالعه طیف ستارگان و دمای آنها کاربرد دارد.

۷) در سلول فوتوالکتریک آند به صورت یک حلقه است؛ چرا که وقتی فوتونها از آند به سمت کاتد که میروند، پس از برخورد
در تمامی جهات مختلف پخش میشوند. بنابراین یک آند حلقوی برای جمعآوری این الکترونها نیاز است.

 ۸) اگر از یک لیزر استفاده کنیم و یک صفحه در جلوی کاتد قرار داده تا فوتوالکترونهای خارج شده از کاتد به صفحه برخورد کنند، در این صورت نمی توان از نور مرئی لیزر پرشدت اشعه ایکس تولید کرد؛ زیرا مرتبه انرژی لیزر هممرتبه با انرژی فوتوالکترونهاست و افزایش شدت نور لیزر تنها و تنها تعداد الکترونهای خروجی را افزایش می دهد. با توجه به توضیحی که قبلا داده شد، انرژی مورد نظر به فرکانس مربوط است و نمیتوان با افزایش شدت فرکانس را تغییر داد. بنابراین فرکانس ایکس دست یافتنی نیست.